銅フタロシアニンの膜成長と非占有準位の空間・エネルギー分布

(阪大院・理) 〇山本 亮太・古澤 潤・山田 剛司・宮久保 圭祐・宗像 利明

[序論]

有機薄膜の成長過程ではµm サイズの不均一な表面構造がしばしば形成される。これは分子 - 基板間・分子間相互作用によるもので、電子状態にも影響を及ぼす。膜の性質を理解する には、空間構造と電子状態の関連を調べる必要がある。われわれはマイクロスポット 2 光子 光電子分光(Micro-2PPE)を用い、CuPc/HOPG の系における LUMO と鏡像準位(IPS)に対し て膜の空間構造が及ぼす影響を調べた。

[実験]

光源に波長可変 Ti:Sa laser (パルス幅 100 fs、繰り返し周波数 76 MHz)の第3高調波(4.1~4.7 eV)を用いて Micro-2PPE 測定を行った。入射光(P 偏光)を回折限界まで集光し、表面法線方向の光電子を検出した。空間分解能 ($\Delta x = 0.4 \mu m$)のみならずエネルギー分解能 ($\Delta E = 30 meV$)が高いことが本装置の特徴である。グラファイト(HOPG)基板は大気下で劈開して超高真空中で加熱して清浄化した。昇華精製した銅フタロシアニン(CuPc)を蒸着後、370 K で 1.5 h アニールした。測定は全て超高真空下、室温で行った。

[結果と考察]

蒸着量 0.2 nm (被覆率 0.6 ML 相当)の CuPc/HOPG のアニールした膜を Micro-2PPE で測 定した結果[1]を図 1 に示す。A は分子の LUMO 由来の準位のピークにアナライザーのエネ ルギーを固定し、試料を走査して得た光電子強度の空間分布の画像で、B は HOPG 基板表面 の n = 1 の鏡像準位 (IPS_{HOPG})のエネルギーで測定した画像である。画像 A の 40×40 µm² の範囲に LUMO の光電子強度(分子密度)が強い(高い)領域と弱い(低い)領域の 2 種類が存在 した。IPS_{HOPG}の強度画像 B にもこの 2 種類の領域に対応する強弱のコントラストがみられ、 A とは強度分布が反転した。アニールした膜でも電子状態が空間的に不均一であり、膜の電 子状態を知るためには顕微測定が不可欠であることが分かる。

電子状態をより詳細に調べるために画像の各点における Micro-2PPE スペクトルを測定した。その結果を図2に示す。横軸は光電子の運動エネルギーを HOPG のフェルミ準位を基準に示している。2種類の領域のどちらでも LUMO 由来のピークが現れ、HOPG 基板のπ*バンド由来のピーク強度が減少した。すなわち、光のスポットサイズ(0.6 μm)より大きな裸の基板は存在しない。LUMO のピークは強度が変化するが、エネルギー位置は場所を変えてもほぼ一定であった。鏡像準位のスペクトルは HOPG 基板表面 (IPS_{HOPG})のピークと1 層膜表面(IPS_{CuPc})の成分のピークが重なって観測された。高密度領域(図1A の赤い領域,図2d,e)では IPS_{HOPG} の強度が小さく、LUMO の強度がほぼ一定で1 層膜のピーク強度に近い。しかし、IPS_{HOPG} が観測されることから穴があいている1 ML 膜と考えられる。観察された2つの領域の面積比を多数のサンプルで調べた結果、高密度領域が1 層膜であるとすると低密度領域の被覆率は約0.3 ML と見積もられ、wetting レイヤーを観測していると考えられる。





図 1: 0.6 ML CuPc/HOPG の LUMO (A) と IPS (B) の電子状態の空間分布



図 2: Micro-2PPE スペクトル (c)。IPS は HOPG 上と CuPc 膜上でシフトして現れ、分子密度が高 い領域では HOPG 成分が減少する。

以前に観測した PbPc/HOPG の場合は、分子配置がランダムであることを反映して、分子 密度が変わると IPS_{HOPG} のエネルギー分布が大きく広がった[2]。CuPc/HOPG の系では IPS_{HOPG} ピークが広がらず、CuPc 膜が核成長することを示している。そこで被覆率を変えて 顕微画像と Micro-2PPE スペクトルを測定して電子状態の空間分布とエネルギー分布の変化 を観測した。

図1よりも薄い膜(0.4 ML まで)は顕微画像に顕著な空間構造が見られず、Micro-2PPE スペクトルは図1の低密度領域(図2a, b)のものに近い。よって図1の青色領域と同様に wetting layer が分布していると考えられる。

図1に更に分子を蒸着し、蒸着量 0.35 nm (図1の1.5倍)とすると、顕微画像はほぼ均一になった。LUMOのピーク位置と強度は図2d, e とほぼ同じであるが、IPS は IPScuPc 成分のみとなった。このことからこれを被覆率1ML と定義した。

1.5 ML では再び顕微画像が空間的に不均一となり、2 層膜と 1 層膜を Micro-2PPE スペクトルから区別できた。2 層目の LUMO ピーク位置は 1 層目の LUMO より数十 meV 程度安定化した。

図2でCTと示したピークは1ML以上で強度が増大した。特に2MLでは明瞭なピーク が観測され、IPScupeと同程度の強度になった。このピークは IPSと同様にS偏光では消失 した。分子由来のLUMOピークは、S偏光で強度が1/4になるが消失せず、対照的である。 ペンタセンでは本来は非局在の IPS の電子が分子膜の HOMO ホールと結合し、局在した CT-exciton に緩和することが知られている[3]。CTピーク強度が増大すると IPScupeの強度は 減少したので、エキシトンとした帰属と矛盾がない。図2d, eにCTピークが弱いながらも 観測されたのは、一部2MLの膜ができたためと考えられる。

[参考文献]

[1] 山本 亮太・古澤 潤・山田 剛司・宮久保 圭祐・宗像 利明 第3回分子科学会 1D17

[2] 山本 亮太, 渋田 昌弘, 山本 健太, 宮久保 圭祐, 山田 剛司, 宗像 利明 第2回分子科学会 2P082

[3] C. D. Lindstrom, M. Muntwiler, and X.-Y. Zhu, J. Phys. Chem. B 111, 6913 (2007)